

BaCo_xTi_xFe_{12-2x}O₁₉(1.0 ≤ x ≤ 5.0) 재료의 Microwave 유전특성

김 찬 육 · 조 남 응

(재) 포항산업과학연구원

Microwave Dielectric Properties of BaCo_xTi_xFe_{12-2x}O₁₉(1.0 ≤ x ≤ 5.0) Materials

Chan Wook Kim and Nam Woong Cho

RIST, Pohang 790-330

(1998년 5월 19일 받음, 1998년 6월 25일 최종수정본 받음)

초 록 BaCo_xTi_xFe_{12-2x}O₁₉(1.0 ≤ x ≤ 5.0) 의 치환양 x에 따른 마이크로파 유전특성을 조사하기 위하여 5~10GHz 대역에서의 공명주파수 f_0 및 무부하인자 Q_u 를 wave guide 방법으로 측정하였다. 측정결과, 치환양의 증가에 따라 유전율은 14.7(x=1)에서 23.4(x=5) 까지 증가하였으며 계산결과 loss tangent는 모두 10^{-3} 정도로 작았다. 이러한 제특성은 저비용으로 제조가능한 CoTi 치환형 Barium ferrite가 유전체 공진기 안테나 등 마이크로파 소자에 응용이 가능한 유망한 재료임을 보여주었다.

Abstract The resonant frequency f_0 and unloaded quality factor Q_u of CoTi-substituted Barium ferrites(BaCo_xTi_xFe_{12-2x}O₁₉, 1.0 ≤ x ≤ 5.0) were measured at frequencies between 5 to 10GHz using the paralleled copper-plate wave guide method. The measurements showed that the permittivities of CoTi-substituted Barium ferrites(CoTi-BF) increased from 14.7 to 23.4 with the contents of CoTi, x, and the loss tangents had values of 10^{-3} order. From these results, CoTi-BF are considered to be very promising materials in microwave devices such as dielectric resonator antennas.

1. 서 론

최근 전자통신기기의 발달과 더불어 위성통신시대가 도래하는 등 전자통신 분야의 새로운 시대가 전개됨에 따라 마이크로 웨이브 부품에 사용 가능한 dielectric resonator (이후 DR로 약칭함)의 개발에 초점이 모여지고 있다. DR의 특징으로서는 기존의 값비싼 metallic-cavity resonator에 비해 비용이 저렴하며 동일한 주파수에서 작동기능이 우수하고 집적화된 마이크로웨이브에 사용할 수 있도록 소형화가 가능하는 등 금후 기존의 resonator를 대체할 수 있을 것으로 전망하고 있다. 그러나 DR의 성능은 궁극적으로 DR 재료의 유전특성에 좌우되며 사용부품의 주파수 대역에 적절한 재료를 선택하여 설계할 필요가 있는 등 재료의 특성이 거의 DR의 성능을 좌우한다.

일반적으로 DR부품으로 적용가능 여부를 결정짓는 유전체의 가장 주요한 특성은 loss tangent과 직접 관련있는 quality factor (Q), 유전율 및 공명주파수에 영향을 미치는 온도계수 등을 들 수 있으며, 마이크로 웨이브 대역에서 이를 특성을 제어 할 수 있는 재료설계에 관한 연구가 필요한 실정이나 이에 대한 연구는 거의 이루어지지 않고 있다.

한편 Barium ferrite(BaFe₁₂O₁₉)¹⁾는 육방정의 결정구조를 가지는 ferri자성 산화물로써 기계적 강도 및 화학적으로 안정하고 높은 전기저항($10^{-8} \Omega\text{cm}$) 특성을 가지고 있으며 Curie온도 이하에서는 열안정성이 우수한 특성²⁾을 보유하는 등 유전재료로써 우수한 특징을 겸비하고 있다.

따라서 본 연구에서는 Barium ferrite의 육방정구조 중 Fe site에 Co 및 Ti을 치환함으로써 그 치환양과 마이크로파 유전특성 및 유전율변화와의 관계 등에 대한 기초적인 정보를 얻고자 하였으며 또한 CoTi 치환형 Barium ferrite가 사용주파수가 마이크로파 대역, 특히 1~10GHz 대역인 DR 안테나소자에 적용가능한 지에 대하여도 검토하였다.

2. 실험 방법

시료 제작

본 실험에서 치환형 Barium ferrite 시료는 순도 99.9% 이상의 BaCO₃, Co₃O₄, TiO₂ 및 Fe₂O₃를 출발원료로 하여 고상반응법을 이용하여 합성하였다. CoTi 치환형 Barium ferrite(이하 CoTi-BF로 기술함) 시료의 제작방법은 다음과 같다. 먼저 CoTi 치환양별로 BaCo_xTi_xFe_{12-2x}O₁₉ 시료를 제작하기 위하여 x=1.0, 2.0, 3.0, 4.0 및 5.0이 되도록 각각의 조성비별로 출발원료를 평량한 후 에탄올을 분산매로 하여 zirconia ball mill로 8시간 혼합하였다. 이것을 373K에서 완전히 건조한 다음 1323K에서 3시간 동안 하소하였으며 하소된 분말은 재차 에탄올과 zirconia ball mill을 사용하여 24시간동안 2차 혼합·분쇄하였다. 이 분말을 건조기에서 373K로 완전히 건조시킨 후 원통형 금형으로 가성형 한 후 CIP(cold isostatic press)를 이용하여 800kg/cm²로 성형하였으며, 또한 성형된 시편은 대기중에서 1473K에서 4시간 동안 소결반응을 행하여 최종적으로 직경 및 높이가 각각 8 및 9mm인 원통형 시편을 제작하였다.

제작한 시편은 $\text{CoTi}_{10}\text{Fe}$ site에 치환되었는지를 확인하기 위하여 RIGAKU사제 X선 발생장치(50KV, 150mA)로부터 발생되는 $\text{Cu}-\text{K}_\alpha$ X선원을 이용하여 step scan 0.02° 간격으로 X선 회절패턴을 측정하였다.

유전율의 측정

초고주파 영역에서의 복소유전율 및 투자율 측정은 주로 전송선과 금속 공동공진기(metallic-cavity resonator)를 이용하여 측정하나, 전송선방법은 넓은 주파수 대역에서 측정할 수 있는 반면 측정오차가 크고 금속공진기방법은 정확한 측정은 가능하지만 공진 모드를 식별하는 데 어려운 단점이 있다. 따라서 본 연구에서는 측정오차가 작으며 비유전율이 10 이상이 되는 경우에 매우 정확한 측정이 가능한 것으로 보고된 Courtney방법³⁾을 이용하여 TE₀₁₁ 모드로 측정하였다.

그림 1은 본 실험에서 사용한 유전율 측정장치를 나타낸다. 직경이 200mm인 pararell copper plate wave guide 중앙에 DR를 위치시킨 후 스위프 발진기로부터 동축선 단부에 부착된 probe를 DR에 접근시켜 원하는 모드를 공진시키고 반대편에서 커플링된 신호를 network analyzer(model : HP 8510)로 보내어 공진주파수와 무부하 Q를 측정하였다. 이때 probe를 시편에 접근시키는 정도에 따라 referenec level이 변하나 이에 따라 대역폭 Δf 도 변하므로 유전율 계산시 보정이 되며 본 실험에서는 referenec level을 -15.87dB로 하였다.

3. 원통형 유전체 공진기 이론

복소 유전율의 계산

비유전율이 ϵ_r 이고 비투자율이 μ 인 등방성인 원통형 유전체 공진기(직경 2a, 높이 L)를 무한히 넓은 두

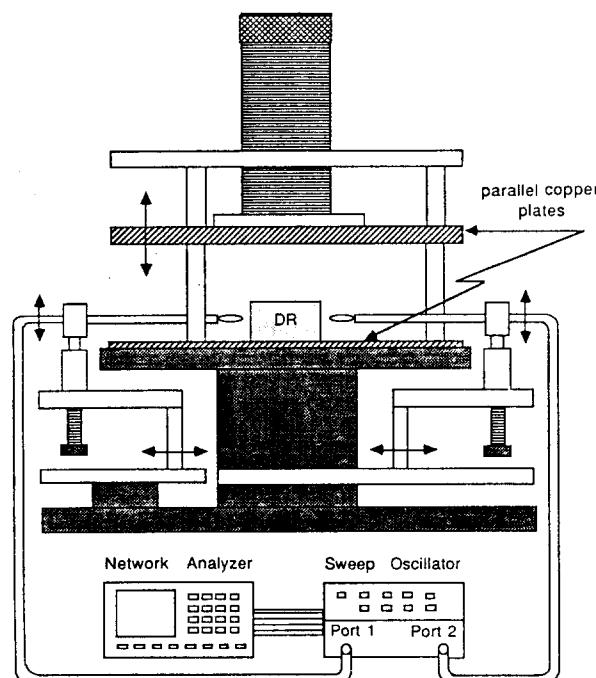


Fig. 1. Configuration of permittivity measuring system.

개의 평면도체 사이에 놓고 전자파를 유기시켰을 때 공진을 일으키는 HEM_{mnp}모드의 특성방정식⁴⁾은 $r=a$ 에서 전자계의 접선성분이 연속인 경계조건을 만족한다면 다음의 식 (1)과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned} [\mu, \frac{J'_m(u)}{uJ_m(u)} + \frac{K'_m(v)}{uK_m(u)}] \\ [\epsilon_r, \frac{J'_m(u)}{uJ_m(u)} + \frac{K'_m(v)}{uK_m(u)}] = R_m^2(u, v) \quad (1) \\ R_m(u, v) = \frac{\beta_m}{\omega_0^2 \sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \left[\frac{1}{u^2} + \frac{1}{v^2} \right] \\ \beta = \frac{p\pi}{L} \quad (p=0, 1, 2, 3, \dots) \end{aligned}$$

여기서 J_m 및 K_m 은 각각 1종 및 2종 Bessel함수이며 J'_m 및 K'_m 은 각각의 함수에 대한 1차 미분함수이다. 또한 u 및 v 는 다음과 같은 관계가 있다.

$$u^2 = (\omega_0^2 \epsilon_0 \mu_0 \epsilon_r \mu_r - \beta^2) a^2, \quad v^2 = (\beta^2 - \omega_0^2 \epsilon_0 \mu_0) a^2 \quad (2)$$

또한, 식 (1) 및 (2)를 이용하여 유전율 및 투자율의 관계를 u 및 v 의 함수로 나타내면 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\epsilon_r \mu_r = \frac{u^2 + v^2}{\omega_0^2 \epsilon_0 \mu_0 a^2} + 1 \quad (3)$$

따라서 유전체 공진기의 공진모드(mnp), 공진주파수 ($f_0 = \omega_0 / 2\pi$) 및 유전체 공진기의 차수(L 및 a)로부터 v 를 계산한 후 식 (1)을 만족하는 u 값을 Newton-Rapson방법으로 계산하여 식 (3)으로부터 유전율을 구할 수 있다. 그러나 식 (3)은 변수가 2이므로 유전율을 구하기 위해서는 기지인 Ba ferrite의 투자율 μ 을 활용하여 유전율 ϵ_r 를 계산할 수가 있다. 본 연구에서는 보다 정밀한 유전율 계산을 위하여 조성이 동일한 시편을 원통형 시편의 높이 L만을 달리하여 ($L = 4.5, 9.0\text{mm}$, a 는 동일) 동일한 조건하에 각각 2시편씩 측정하여 CoTi 치환형 Ba ferrite의 유전율을 구하였다. 투자율은 평가결과 치환양에 관계없이 거의 1에 가까운 수치를 나타내었다.

유전손실 탄젠트의 계산

유전손실은 공진기영역(시료) 및 진공영역중에 저장된 전기 에너지, 유전체의 자체 전력손실 및 표면도체(parallel Copper plate)의 표면저항에 의한 전력손실 등의 총화이며 이들 관계식과 Bessel 함수와의 관계식들로부터 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} \delta_r &= \frac{A}{Q_u} - BR_s, \quad (4) \\ A &= 1 + \frac{W_p}{\epsilon_r}, \quad B = \frac{4X_p}{\omega \epsilon_0 \epsilon_r L} \end{aligned}$$

여기서 W_p 및 X_p 는 Bessel 함수의 적분값⁵⁾으로 R_s 는 평면도체의 표면저항을 나타낸다. 또한 무부하 인자 Q_u 는 부하 인자 Q_L 과 유전체 삽입손실 S_{21} 을 알면 다음과 같은 관계식으로부터 구할 수 있으며, Q_L 은 공진주파수 f_0 및 대역폭

Δ 의 관계로부터 구할 수 있다.

$$Q_w = \frac{Q_L}{1 - |S_{21}|}, \quad Q_L = \frac{f_0}{\Delta} \quad (5)$$

결국 유전손실 탄센트는 공진주파수에서 유전체 공진기의 무부하 Q_w 및 평면도체의 표면저항과 전술한 식 (3)을 이용하여 산출한 유전율로부터 구할 수 있다.

4. 결과 및 고찰

고상반응법을 이용하여 합성한 CoTi-BF의 치환양 x에 따른 X선 회절패턴을 그림 2에 나타내었다. X선 회절패턴은 미치환된 순수 Barium ferrite의 회절패턴과 동일한 형상을 보이고 있으며 2차상에 의한 회절피크가 관측되지 않아 CoTi이 Barium ferrite에 잘 고용이 되었음을 보여주고 있다. 또한 치환양 x가 증가함에 따라 회절강도는 (00L)면이 우선배향되어 커지고 있으며 또한 회절피크는 저각축으로 이동하는 양상을 보이고 있어 치환양이 많을수록 저각축으로 shift되는 정도가 커 고용에 의한 격자상수가 증가함을 반영하고 있다. 이는 측정된 회절패턴을 활용하여 Rietveld profile-analysis를 행한 저자 등의 연구결과⁶⁾를 분석하면 기존의 이온(Fe⁺)보다 이온반경이 큰 이온(Co²⁺, Ti⁴⁺)이 고용되었음을 의미한다.

그림 3 및 그림 4는 그림 1의 측정장치를 이용하여 측정주파수가 5~10GHz의 영역에서 측정한 시료별 공진패턴 특성의 일례를 보여준다. 그림 3은 x=1의 경우의 CoTi-BF의 공진패턴 profile로써 이러한 공진패턴은 치환양 x와 관계없이 유사한 공진패턴을 나타내었다. 그림 3을 x=5인 경우의 그림 4와 비교하면 치환양이 적을수록 공진피크가 broadening해지는 경향을 보이고 있다. 이는 x=1의 경우에 시료의 유전손실이 x=5인 경우보다 크기 때문으로 분석된다. 즉, 유전손실 tan δ가 상대적으로 크다는 것은 손실분율이 커 Q_L 이 작아짐을 의미하므로 결국 Δ 가 커지는 결과가 공진파형 profile에 반영된 것으로 해석된다. 표 1에 전술한 유전율 측정방법으로 측정한 시료별 유전율을 나타내었다.

그림 5에는 CoTi 치환양 x에 따른 Barium ferrite의 복

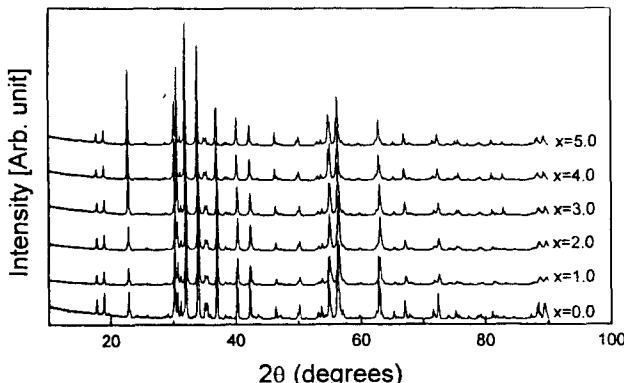


Fig. 2. X-ray diffraction profiles of CoTi substituted Barium ferrites.

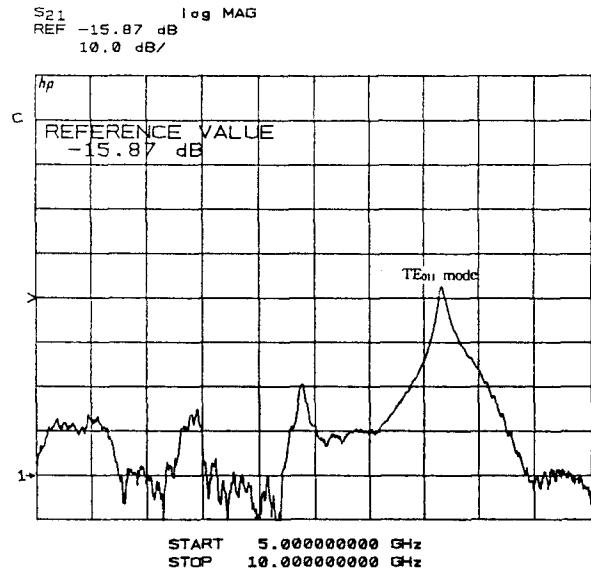


Fig. 3. Resonance characteristics of CoTi substituted Barium ferrites ($x=1$).

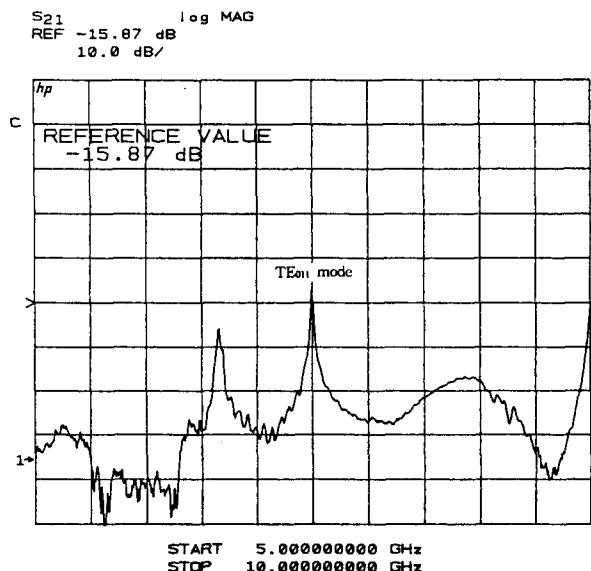


Fig. 4. Resonance characteristics of CoTi substituted Barium ferrites ($x=5$).

소유전율 변화를 나타내었다. $x=1$ 인 경우의 유전율은 14.67이었으며 치환양이 증가함에 따라 유전율의 실수항이 완만한 형태로 증가하여 $x=5$ 일때는 23.38을 나타내고 있다 (표 1. 참조). 이와 같이 CoTi 치환양이 증가함에 따라 유전율이 증가하는 것은 CoTi의 치환양이 증가함으로써 조성변화에 따라 비유전율에 기여하는 이온분극화 비율이 증가하기 때문으로 해석된다. 비유전율 ϵ_r 과 CoTi 치환양 x의 관계를 치환양 x의 함수로 나타내기 위하여 복소유전율(실수항)의 변화를 fitting하면 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\epsilon_r(x) = -0.66x^2 + 6.12x + 9.27 \quad (6)$$

식 (6)은 CoTi의 치환양 x를 조절함으로써 측정 주파수가 5~10GHz 대역에서 비유전율의 값을 예측하거나 혹은 재료설계를 행하는 데 유효한 실험식으로 사용가능하다.

Table 1. Results of dielectric measurements.

sample, x	2a(mm)	L(mm)	f_0 (GHz)	Δ (MHz)	S_{21} (dB)	ϵ_r	$\tan \delta_e (\times 10^{-3})$
1	8.4	8.6	8.6951	54.2	-33.1	14.68	6.2
2	8.4	8.5	8.1401	52.7	-33.1	19.10	6.7
3	8.3	8.5	7.7664	55.1	-33.3	21.67	7.0
4	8.3	8.3	7.6281	7.63	-35.4	23.01	0.94
5	8.3	8.4	7.5135	13.33	-35.4	23.38	1.7

또한, 재료손실인 tangent loss를 직접 반영하는 유전율 허수항은 CoTi의 치환양에 따라 0.02~0.15의 수치를 나타내고 있으며 실수항과 유사한 패턴으로 증가하다가 x=4 및 5에서 다소 감소하고 있다. 이 현상을 결정립의 미세구조 측면에서 분석하기 위하여 치환양 x에 따른 Barium ferrite의 기공율 및 겉보기 밀도를 계산하였다. 그 결과를 그림 6에 나타낸다. 단위 체적당 기공율이 증가하면 $|S_{21}|$ 가 커지게 되고(무부하인자 Q_L 가 커짐) 결국 $\tan \delta_e$ 가 작아져 손실이 커지므로 x=4 및 5인 시료의 기공율이 x=1 ~3인 시료의 기공율보다 클 것으로 예측하였으나 측정결과는 그림 6에 나타낸 바와 같이 치환양 x가 증가할수록 기공율이 감소(겉보기 밀도는 증가)하고 있음을 알 수 있

다. 이 결과는 치환양 x가 4 및 5인 시편의 경우 결정립이 조대화하여 기공율이 감소되고 있음을 의미하고 있는 것으로 주사전자 현미경(Scanning Electron Microscope, Jeol-5200)으로 시료의 조직을 관찰한 결과⁶⁾, 예측대로 결정립이 수십 μm 이상으로 크게 성장되고 있음을 확인하였다. 따라서 치환양 x가 4 및 5인 시편의 유전율 허수항이 다소 감소하는 것은 시료의 물성변화에 기인한 결과라기보다는 측정 및 계산오차 등의 부차적 요인에 의한 것으로 생각된다.

그림 7에는 측정한 공진 주파수와 CoTi 치환양과의 관계를 도시한다. 치환양과 유전율과의 관계(표 1참조)와 연계하여 고찰하면 유전율이 낮을수록 공진현상이 고주파대역으로 shift되는 전형적인 패턴을 보이고 있다. 식 (3)의 f_0 와 ϵ_r 과의 관계로부터 공진주파수가 커짐에 따라 유전율이 낮아지므로 f_0 의 shift패턴이 본 측정결과와도 일치하고 있음을 알 수 있다.

이상과 같이 측정실험 결과, CoTi-BF는 전술한 실험식 (6)을 이용하여 치환양 x를 조절하여 유전특성을 제어함으로써 마이크로파 resonator재료로 사용이 가능할 것으로 판단된다. Junker 등⁷⁾의 연구결과를 보면 1.5~5.5 GHz 대역에서 사용할 수 있는 원통형 DR안테나의 coaxial probe(유전율 12~22)의 재료로써 CoTi 치환형 Ba ferrite의 적용이 가능한 것으로 나타나고 있다. 또한, CoTi 치환형 Ba ferrite는 표 2에 나타난 바와 같이 널리 알려진 Fused quartz, Alumina 및 Magnesium titanate 등의 유전특성⁸⁾과도 비견할 수 있는 재료이며, 기존의 이들 재료

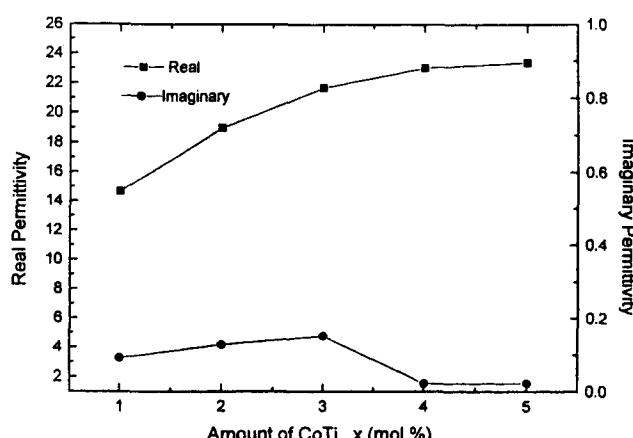


Fig. 5. Dependence of complex permittivities on the amount of CoTi.

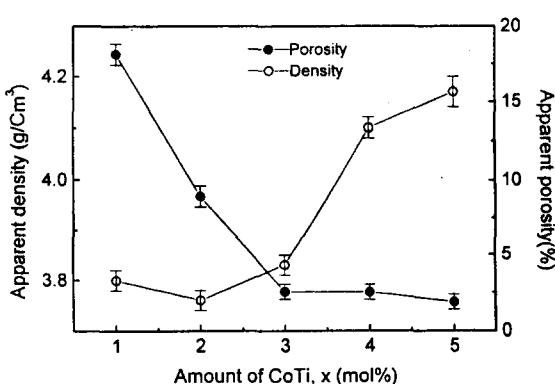


Fig. 6. Dependence of apparent porosity and density on the amount of CoTi.

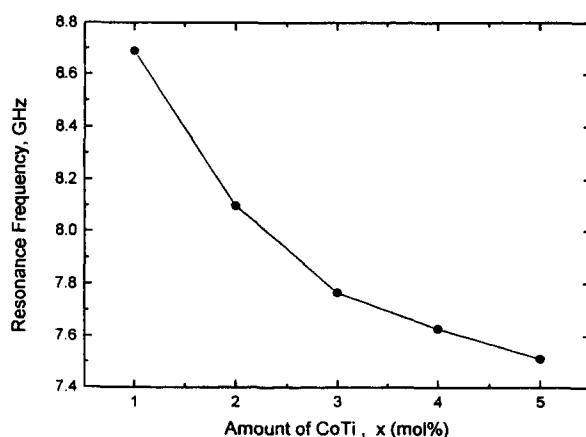


Fig. 7. Dependence of resonant frequency on the amount of CoTi.

Table 2. Dielectric properties of various materials.

Materials	f_0 (GHz)	ϵ_r	$\tan \delta_e (\times 10^{-3})$
Fused silica	9	3.83	0.12
Alumina, 99%	9	9.25	1.0
Magnesium titanate	9	15.85	1.0
CoTi Ba-Ferrite	8.7	14.7	6.2

가 고가인데 비해 저렴하게 대량 생산할 수 있는 특징이 있어 소결조건의 최적화가 이루어지면 금후 유망한 마이크로파 유전재료로써 적극 활용될 것으로 판단된다.

5. 결 론

Barium ferrite의 마이크로파 유전특성을 조사하기 위해 육방정 구조 중 Fe site에 치환되는 CoTi양을 달리하여 시편을 제작하고 이들 시편에 대해 wave guide 방법을 사용하여 TE₀₁₁ 모드로 유전특성을 측정하였다. 측정한 결과를 요약하면 다음과 같다.

1) CoTi-BF는 치환되는 CoTi 양에 따라 7.5~8.7GHz 범위에서 공진하였으며 공진주파수는 치환양이 증가됨에 따라 서서히 감소하는 경향을 보였다.

2) 5~10GHz 대역의 측정주파수에서 CoTi 치환양의 증가에 따라 유전율의 실수부 및 허수부는 각각 14~23 및 0.09~0.12의 값을 나타냈으며 유전손실 또한 10⁻³의 크기로 매우 작았다.

3) CoTi 치환양 x에 따라 C~X band 영역에서의 유전특성 제어가 가능함을 알 수 있었으며 소결조건의 최적화가 이

루어질 경우 금후 CoTi-BF재료는 dielectric resonator antenna 소자 등 마이크로파 부품에 적용가능할 것으로 판단되었다.

참 고 문 헌

1. Y. Kaike and O. Kubo, Ceramics Jpn., **18** (10), 839 (1983).
2. E.P. Wohlfarth, Ferromagnetic Materials vol.3, pp. 448, North-holland publishing co., (1982).
3. W.E. Courtney, IEEE Trans. Microwave Theory Tech., MTT-18, 476 (1970).
4. S. Ramo, J.R. Whinnery and T.V. Duzer, Fields and waves in communication electronics, 2nd ed., pp. 110, John Wiley & Sons, Inc., (1984).
5. B.W. Hakki and P.D. Coleman, IRE Trans. Microwave Theory and Techniques, vol. MTT-8, 402 (1960).
6. N.W. CHO, C.W. KIM and K.P. SUNG, RIST Journal of R & D, in press.
7. G.P. Junker, A.A. Kishk, A.W. Glisson and D. Kaifez, IEEE Antennas and Propagation, **37** (1), 40 (1995).
8. H.E. Bussey, J.E. Gray, E.C. Bamberger, E. Rushton, G. Russel, B.W. Petley and D. Morris, IEEE Trans. Instrumentation and Measurements, IM-13, 305 (1969).